



# Set XF1



- 内 容:**
- H-Fieldプローブ XF-R 400-1
  - H-Fieldプローブ XF-R 3-1
  - H-Fieldプローブ XF-B 3-1
  - H-Fieldプローブ XF-U 2.5-1
  - E-Fieldプローブ XF-E 10
  - ケーブル SMA-SMA
  - ケース 240X185X50mm
  - 取扱説明書(英語版)

## NEAR FIELD PROBE SET **XF1**

FREQUENCY RANGE 30 MHz TO 6 GHz

特 性	説 明	タイプ
	<p><b>XF-R 400-1</b> 直径が25mmと大きいので感度が非常に良く、最小の分析が出来る。プローブは装置から10cmまでの距離に使用可能である。HF電磁界の発生源や障害の発生源の位置測定を可能にする。 周波数レンジ 30MHz~6GHz φ約25mm</p>	
	<p><b>XF-R 3-1</b> HF電磁界のほとんどの点状の検波を行える。プローブはミリメートル範囲の電磁界の解析まで可能。プローブをより広い範囲を移動させたり、導電経路を別々に移動させたり、またICピン・エリア内やバイパス・コンデンサ、EMCコンポーネント等々でも電磁界の指向性や分布を見つけ出せる。 周波数レンジ 30MHz~6GHz 分解約1mm</p>	
	<p><b>XF-B 3-1</b> 平らな装置の表面から垂直に発せられる電磁界の探知用に設計されている。プローブはプリント回路基板の妨げられた部分の測定を可能にするが、XF-R 3-1で出来るような電磁界の指向性測定は実施不可能である。 周波数レンジ 30MHz~6GHz 分解約2mm</p>	
	<p><b>XF-U 2.5-1</b> 極小導電経路、コンポーネントの接続部分、コンデンサ、ICピンの流動スペクトル検波用に設計された。プローブヘッドは約0.5mm幅で磁気によって有効な規制を含む。プローブを導電経路やIC、コンデンサ接続部分に置いて計測する。 周波数レンジ 30MHz~6GHz 分解約0.5mm</p>	
	<p><b>XF-E 10</b> 電磁界を検知する。プローブのヘッド・チップは幅わずか約0.5mm。約0.2mmの分解が可能なので、個々のトラックが設計図上で評価可能。 周波数レンジ 30MHz~6GHz 分解約0.2mm</p>	



### ウェーブクレスト株式会社

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所1-27-5 プレム武蔵浦和7F  
Tel. 048-764-9969 Fax. 050-3488-9847 Email. info@wavecrestkk.co.jp

\* 価格・仕様等は変更される場合がございます。最新の情報はお問い合わせください。